

a 2004 0098

Invenția se referă la tehnologia de producere a semiconductorilor, în special la procedeele de obținere a structurilor semiconductoare poroase.

Procedeul de obținere a structurilor semiconductoare poroase constă în aceea că pe suprafața semiconductorului se depune o mască, pe regiunile neacoperite se implantează ioni de energie înaltă, apoi masca se înlătură, iar suprafața semiconductorului se supune corodării electrochimice. Noutatea constă în aceea că înainte de corodare pe suprafața semiconductorului se depune repetat o mască numai pe regiunile care au fost implantate cu ioni, pe regiunile neacoperite se implantează ioni de energie înaltă diferită de cea anterioară și se înlătură masca.

Revendicări: 1